

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

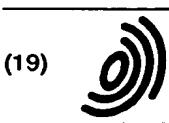
Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**



(19)

Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11)

EP 0 903 638 A1

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:  
24.03.1999 Patentblatt 1999/12

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: G03F 7/039, G03F 7/20

(21) Anmeldenummer: 98115393.5

(22) Anmeldetag: 17.08.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:  
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 19.09.1997 DE 19741492

(71) Anmelder:  
microParts Gesellschaft für  
Mikrostrukturtechnik mbH  
44227 Dortmund (DE)

(72) Erfinder:

- Reinecke, Holger, Dr.  
44287 Dortmund (DE)
- Kapitzka, Norbert  
44369 Dortmund (DE)
- Ballhorn, Ralph-Ulrich  
44227 Dortmund (DE)
- Schäfermeler, Bernhard  
53115 Bonn (DE)
- Spitzner, Ulrike  
44623 Herne (DE)

### (54) Verfahren zur Herstellung von Mikrostrukturkörpern

(57) Zum Herstellen von Mikrostrukturen nach dem LIGA-Verfahren werden Kunststoffschichten mit Röntgenstrahlung bildmäßig tiefenbestrahlt. Die löslich gewordenen oder löslich gebliebenen Bereiche der Kunststoffschichten werden mittels eines Entwicklers selektiv gelöst. Die bekannten Kunststoffe erfordern einen erheblichen Bestrahlungsaufwand.

Beim erfindungsgemäßen Verfahren werden lichthärtende Epoxidlacke verwendet, die im Vergleich zu bekannten Kunststoffen eine kürzere Bestrahlungszeit erfordern. Die Mikrostrukturen können ein großes Aspektverhältnis haben und lassen sich auch bei großer Strukturtiefe einwandfrei entwickeln. Die Strukturgenaugkeiten liegen im Submikrometerbereich.

Das Verfahren gestaltet, tiefe Mikrostrukturen in sehr guter Qualität bei herabgesetztem Bestrahlungsaufwand wirtschaftlich herzustellen.

EP 0 903 638 A1

**Beschreibung**

- [0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Mikrostrukturkörpern mit Strukturtiefen von mehreren Mikrometern bis in den Millimeterbereich, bei Lateralabmessungen im Mikrometerbereich, durch Bestrahlen von Polymeren mit Röntgenstrahlung und nachfolgender Entwicklung mit geeigneten Entwicklermedien.
- [0002] In der Mikroelektronik hat die konsequente Miniaturisierung und Integration zu einer unüberschaubaren Vielfalt neuer Produkte mit entsprechenden Technologien geführt. Die Mikroelektronik hat in wenigen Jahren gegenüber anderen Industriezweigen einen gewaltigen Vorsprung in der Miniaturisierung gewonnen. Inzwischen zeichnet sich ab, daß in Zukunft auch andere Mikrotechniken eine große Bedeutung erlangen werden, wobei insbesondere die Mikromechanik und die integrierte Optik sowie die Mikrofluidik zu erwähnen sind. Solche Technologien eröffnen in Kombination mit der Mikroelektronik eine unvorstellbare Zahl neuer elektronischer, optischer, biologischer und mechanischer Funktionselemente. Bei einer Massenfertigung von nichtelektronischen Bauelementen, Systemkomponenten und Subsystemen der Mikrotechnik wird man naturgemäß die außerordentlich leistungsfähigen Fertigungsmethoden der Halbleitertechnik in möglichst großem Umfang nutzen. Gleichzeitig wurden klassische Methoden der Feinwerktechnik für die Mikromechanik erachtigt und mit entsprechend modifizierten Halbleiterfertigungsmethoden verschmolzen, um so die engen Grenzen der Siliziumplanartechnik verlassen und neue Gestaltungsmöglichkeiten erschließen zu können, die auf einer Vielzahl von Formen und Materialien aufzubauen. Diese Forderung wird zum Beispiel im hohen Maße durch das LIGA-Verfahren erfüllt, das aus den Fertigungsschritten Lithographie, Galvanoformung und Abformung aufgebaut und am Kernforschungszentrum Karlsruhe entwickelt worden ist. Der wesentliche Fertigungsschritt des ursprünglichen LIGA-Verfahrens ist die strukturgenaue Bestrahlung des eingesetzten Polymers. Die prinzipielle Durchführbarkeit des LIGA-Verfahrens konnte anhand einfacher Mikrostrukturen mit einem speziell hergestellten Polymethylmethacrylat, im folgenden PMMA genannt, nachgewiesen werden. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Kunststoffe, die zur Bestrahlung mit Röntgenstrahlung entwickelt wurden. Insbesondere sind hier das Polyoximethylen (POM) und Polyester, insbesondere Polyglykolide/-laktide (DE - 41 41 352 A1) hervorzuheben.
- [0003] Der Einsatz des Epoxidresists SU8 für die Strukturierung mittels UV-Lithographie ist in mehreren Veröffentlichungen beschrieben worden. (High-Aspect-Ratio, Ultrathick, Negative-Tone Near-UV Photoresist for MEMS APPLICATIONS: M. Despont, H. Lorenz, N. Fahrin, J. Brügger, P. Renaud and P. Vettiger, Proc. of the 10th IEEE Int'l Workshop on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS'97) Jan. 26-30, 1997, Nagoya, Japan; Micromachining applications of a high resolution ultrathick photoresist: Lee, La Bianca, et al., J. Vac. Sci. Technol. B.13(6), Nov/Dec 1995).
- Weiter werden Epoxidmischungen für die Kapselung von zum Beispiel mikroelektronischen, elektronischen oder optischen Bauteilen eingesetzt (siehe PROTAVIC-Broschüre).
- [0004] Bei der Herstellung komplexen dreidimensionaler Strukturen mit Strukturtiefen von mehreren Mikrometern bis in den Millimeterbereich nach dem oben genannten LIGA-Verfahren hat sich gezeigt, daß die bestehenden Kunststoffe einen hohen Bestrahlungsaufwand erfordern. Weiter hat sich gezeigt, daß bei der Entwicklung der bestrahlten Polymeranteile mit einem geeigneten Entwicklermedium die unbestrahlten Polymeranteile quellen, wobei feine Mikrostrukturen zerstört werden können. Andererseits können gequollene Polymeranteile beim Austrocknen zu SpannungsrisSEN führen, die bei der Galvanik unbrauchbare Mikrostrukturkörpern ergeben. Ein weiteres Problem besteht in der aufwendigen Verarbeitbarkeit bestimmter Kunststoffe, insbesondere von Polylaktiden und Polyglykoliden, die durch aufwendige Prägevorgänge, auf Substraten zur Bestrahlung aufgebracht werden müssen.
- [0005] UV-härtende Lacksysteme können zur Herstellung von Mikrostrukturen eingesetzt werden. Dabei ist allerdings eine Submikrometergenauigkeit, wie sie für optische und fluidische Komponenten oft notwendig ist, aufgrund von Beugungs-, Streu- und Interferenz-Effekten des eingesetzten Lichtes (Wellenlängen 300 nm bis 460 nm) nicht erreichbar, wenn die Schichtdicken im Mikro- und Millimeterbereich liegen.
- [0006] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Polymer zu finden, welches einen geringen Bestrahlungsaufwand bei Bestrahlung mit Synchrotronstrahlung erfordert und unter dem Einfluß von Röntgenstrahlung depolymerisiert oder verernetzt wird und mit speziellen Entwicklern selektiv entfernbare ist. Das Polymere soll ferner eine einfache Probekörperherstellung aufweisen und keine Spannungsrisse und keine Fehlstellen zeigen. Eine weitgehende Kompatibilität mit Halbleiterfertigungsprozessen ist anzustreben.
- [0007] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von Mikrostrukturkörpern mit Strukturtiefen von mehreren Mikrometern bis in den Millimeterbereich durch bildmäßiges Bestrahlen von Polymeren mit Röntgenstrahlung, das dadurch gekennzeichnet ist, daß als Polymere UV- und lichthärtende Epoxidlacke verwendet werden. Als Röntgenstrahlung kann vorzugsweise Synchrotronstrahlung eingesetzt werden. Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens können die Epoxidlacke durch Pressen, Extrudieren, Prägen, Spritzgießen oder Spin-coaten auf einen Träger aufgebracht werden. Das Verfahren kann mehrstufig durchgeführt werden.
- [0008] Überraschenderweise wurde gefunden, daß die aus dem Bereich der Halbleiterfertigung bzw. Kunststofftechnik bekannten lichthärtenden Epoxidlacke durch Röntgenstrahlung strukturierbar sind und die oben genannten Forderungen erfüllen. Die Verwendbarkeit der unter Röntgenlicht aushärtenden Epoxidlacke zur Herstellung von Mikrostrukturkörpern, bei denen es auf ein hohes Aspektverhältnis ankommt, wie dies beispielsweise für das LIGA-Verfahren

erforderlich ist, und die sich dabei ergebenden Vorteile waren überraschend und konnten aus den bisher bekannten Druckschriften nicht hergeleitet werden.

[0009] Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren lassen sich Mikrostrukturkörper mit Strukturtiefen von 1 Mikrometer bis 10 Millimeter herstellen, so daß durch Bestrahlung mit Synchrotronstrahlung und Einwirkung selektiver Entwickler

5 in einer Abtragstiefe von 1 µm bis 10000 µm bei lateralen Abmessungen im Mikrometer- bis in den Submikrometerbereich strukturiert werden kann. Als selektive Entwickler eignen sich organische Lösemittel und alkalische Medien, vorzugsweise zum Beispiel Propylenglykolmonomethylether-acetat (PGMEA), Hydroxidlösung mit Glykolanteilen oder alkoholische Alkalihydroxidlösungen.

[0010] Die Bestrahlung erfolgt beim erfindungsgemäßen Verfahren mittels energiereicher paralleler Strahlung aus Röntgenstrahlquellen. Die Wellenlängen dieser Strahlen liegen in einem Bereich von 0,1 nm bis 10 nm, vorzugsweise von 0,1 nm bis 1 nm. Derartige Bestrahlungen können beispielsweise an einem Synchrotron mit speziellen Vorabsorbern zum Beispiel aus Beryllium oder Polyimidfolie (zum Beispiel Kapton der Firma Dupont de Nemours) mit Bestrahlungszeiten von 1 Minute bis 300 Minuten bei einem mittleren Bingstrom von zum Beispiel 25 mA durchgeführt werden.

[0011] Der Bestrahlungsaufwand ist abhängig von der Elektronenergie im Elektronenspeicherring, der vom Syn-

15 chrotron abgezweigt ist. Im allgemeinen beträgt die Elektronenenergie 1,0 GeV bis 2,7 GeV.

[0012] Zur bildmäßigen Bestrahlung werden üblicherweise spezielle Röntgenmasken beispielsweise aus einer Titan-

Beryllium- oder Diamantträgerfolie mit Gold- oder Wolfram-Absorberstrukturen verwendet.

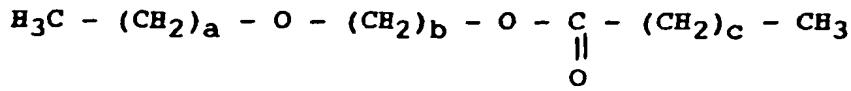
[0013] Für das erfindungsgemäße Verfahren eignen sich besonders der Epoxidlack SU8 (vertrieben durch die Firma micro resist technology), oder die flüssigen Photoresists zum Ätzen von Leiterplatten der Firma Lackwerke Peters

20 GmbH, die unter den Produktnamen ELPEMER bekannt geworden sind. Beispiele für weitere einsetzbare Komponenten sind die Schutzlacke der Firma Protex, die unter den Namen PROTAVIC PU und PROTAVIC UV auf dem Markt

erhältlich sind.

[0014] Zur Herstellung von Mikrostrukturkörpern können Epoxidlacke durch übliche Verfahren wie zum Beispiel durch Pressen, Spritzguß, Extrusion oder Spincoaten bei Temperaturen zwischen 20 °C und 100 °C auf feste Träger, bevorzugt elektrisch leitende Metallträger wie Nickel, Kupfer, Stahl oder Titan, aufgebracht werden. Dabei können gegebenenfalls Haftsichten, Haftlacke oder spezielle Haftvermittler eingesetzt werden. Die Schichtdicke der Epoxidlacke auf den Trägern liegt im allgemeinen zwischen 1 µm und 10.000 µm, vorzugsweise zwischen 10 µm und 1.000 µm, insbesondere zwischen 100 µm und 800 µm.

[0015] Nach dem bildmäßigen Bestrahlen wird mit geeigneten Entwicklermedien entwickelt. Als Entwickler können 30 Systeme auf Basis von Alkylglycol-alkylether-alkylmonocarbonsäure-ester der allgemeinen Formel



35

40 mit a = 0 bis 5, b = 2 bis 4, c = 0 bis 5

oder deren Isomere, wie Propylenglykol-monomethylether-acetat, Propylenglykol-monoethylmethylether-acetat, Ethylenglykol-butylether-acetat, Butylenglykol-isopropylether-propionat, oder basische Entwickler wie Alkalihydroxidlösungen kombiniert mit Glykolen oder alkoholische Alkalihydroxidlösungen eingesetzt werden.

45 [0016] Das erfindungsgemäß Verfahren hat folgende Vorteile:

- Das eingesetzte Polymer ist mikrostrukturierbar; das Polymer ermöglicht die Herstellung von Mikrostrukturen bis hinab zu einer Strukturbreite von wenigen Mikrometern bei gleichzeitig hohem Aspektverhältnis (Verhältnis von Strukturhöhe zu Strukturbreite) von 5 : 1 bis 1000 : 1, vorzugsweise von 10 : 1 bis 100 : 1.
- 50 - Mit den angegebenen Epoxidlacken werden bei gleichem Bestrahlungsaufwand Mikrostrukturen mit wesentlich größeren Strukturtiefen erhalten als mit bekannten Kunststoffen. Im Vergleich zu Polymethyl-methacrylat (PMMA) liegt eine Steigerung der Empfindlichkeit um einen Faktor 100 bis 1000 vor.
- Es lassen sich Strukturen mit Strukturhöhen von zum Beispiel 500 µm bei lateralen Abmessungen im Submikrometer-Bereich herstellen, die keine Defekte aufweisen.
- 55 - Es ermöglicht Strukturgenauigkeiten im Submikrometerbereich zu erzielen.
- Die Mikrostrukturen haben scharfe, steile Kanten und glatte Wände.
- Das Polymer ist bis 80 °C mechanisch stabil und hat eine ausreichende thermomechanische Festigkeit.
- Das Polymer übersteht Galvanikprozesse problemlos und ist beständig gegen zum Beispiel saure Kupfer- und Nik-

kelbäder, Schwefelsäure und Amidoschwefelsäure sowie Komplexbildner. Bei Temperaturen zwischen 20 °C und 80 °C bleiben die Mikrostrukturen über 24 Stunden in den Galvanikbädern unverändert.

- Die Oberfläche des Kunststoffs ist glatt; er lässt sich in gleichmäßiger Schichtdicke auf dem Träger auftragen.
- Die angegebenen Entwickler haben eine sehr gute Selektivität.
- 5 - Diese Epoxidlacke sind für den LIGA-Prozeß hervorragend geeignet und auf den in der Halbleitertechnik verwendeten Anlagen sehr gut verarbeitbar.

[0017] Das erfindungsgemäße Verfahren wird anhand der folgenden Beispiele näher erläutert, ohne darauf beschränkt zu sein.

- 10 **Beispiel 1:**

[0018] Auf einen Träger mit den Abmessungen 100 mm Durchmesser und 0,5 mm Dicke aus Silizium (Wafer) wurde durch Spincoaten eine Schicht Epoxidlack SU8 von  $(505 \pm 25)$  µm Schichtdicke aufgetragen. Dieser Resist wurde auf einer Hotplate bei 90 °C getrocknet und danach an einem Synchrotron mit 2,3 GeV Elektronen-Energie 35 Minuten bei einem mittleren Ringstrom von 20 mA und einem Scannerhub von 20 mm bei einer Scannergeschwindigkeit von 1 mm/s durch eine Röntgenmaske mit Teststrukturen (Felder mit sechskantigen Säulen von 1 µm bis 500 µm Durchmesser) bildmäßig bestrahlt. Die Entwicklung fand bei 25 °C mit PGMEA in 25 Minuten statt. Die Struktur war vollständig frei entwickelt. Der strukturierte Epoxidlack ist an typischen Strukturen völlig frei von Entwicklungsresten und zeigt eine hervorragende Entwickelbarkeit von Einzelsäulen bis in den Bereich von 5 µm (Schlüsselweite).

[0019] **Vergleichsbeispiel 1:** Ein Probekörper aus PMMA wurde unter den entsprechenden Bedingungen 60 Minuten bestrahlt und mit dem für PMMA optimierten Entwickler (GG-Entwickler) entwickelt. Der Abtrag betrug nur 100 µm. Bei den entsprechenden Säulenstrukturen war maximal die Säule mit einem Durchmesser von 50 µm vorhanden. Säulen mit kleinerem Durchmesser waren verbogen oder zerstört.

[0020] Wie der Vergleich dieser beiden Beispiele zeigt, müssen Strukturhöhen von etwa 500 µm bei PMMA unter gleichen Bedingungen mindestens 10 Stunden bestrahlt werden. Hierbei sind Aspektverhältnisse bis zu 40 erreichbar. Bei SU8 dagegen lassen sich dickere Strukturen bei kürzerer Bestrahlungszeit mit höherem Aspektverhältnis wirtschaftlicher und gleichzeitig mit höherer Qualität herstellen.

- 30 **Beispiel 2:**

[0021] Auf eine Trägerplatte aus Kupfer wurde der Epoxidlack ELPEMER SD 2054 mit einer Dicke von 300 µm durch Spincoaten aufgebracht und an einem Synchrotron mit 2,3 GeV Elektronen-Energie 15 Minuten bei einem mittleren Ringstrom von 20 mA und einem Scannerhub von 20 mm durch eine Röntgenmaske mit Spektrometerstrukturen bildmäßig bestrahlt. Zur nachfolgenden Entwicklung wurde eine fünfprozentige Lösung von Natriumhydroxid in 1 : 1 Wasser/Glykol bei 25 °C und 75 Minuten eingesetzt. Die Struktur war vollständig frei entwickelt. Das strukturierte Epoxid zeigt an den typischen Gitterzähnen der Spektrometerstruktur eine hervorragende Abbildung der funktionsbestimmenden Zahnkanten. Das Spektrometer ist frei von singulären und statistischen Fehlstellen.

[0022] **Vergleichsbeispiel 2:** Ein Probekörper aus PMMA auf Kupfer mit einer Schichtdicke von 300 µm wurde unter den gleichen Bedingungen bestrahlt, bis eine PMMA-typische Bestrahlldosis für 300 µm eingelagert wurde. Die Bestrahlzeit betrug 6 Stunden. Die Entwicklung erfolgte mit GG-Entwickler. Bei den Zähnen ergab sich ein Dunkelabtrag sowie eine Verrundung der Strukturen über die ganze Zahnhöhe. Die so erzeugte Struktur weist singuläre und statistische Fehlstellen auf.

[0023] Wie der Vergleich dieser beiden Beispiele zeigt, kann die vorgegebene Gitterstruktur für ein Mikrospektrometer mit den typischen Gitterzähnen mit PMMA realisiert werden, wenn erfahrungsgemäß die Mikrostruktur unter 150 µm dick ist. Bei SD 2054 dagegen kann die zu bestrahlende Schicht dicker sein; trotzdem entsteht bei deutlich kürzerer Bestrahlungszeit eine Gitterstruktur mit einwandfreier Zahnform.

#### Patentansprüche

- 50 1. Verfahren zur Herstellung von Mikrostrukturkörpern mit Strukturtiefen von mehreren Mikrometern bis in den Millimeterbereich durch bildmäßiges Bestrahlen von Polymeren mit Röntgenstrahlung und selektives Auflösen der löslich gewordenen oder löslich gebliebenen Bereiche, dadurch gekennzeichnet, daß
- 55 - als Polymer ein licht- und UV-härtender Epoxidlack eingesetzt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß

- als Röntgenstrahlung Synchrotronstrahlung eingesetzt wird.
3. Verfahren nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß
- 5 - der Epoxidlack bevorzugt durch Spincoaten oder Gießen auf einen Träger aufgebracht wird.
4. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß
- 10 - Mikrostrukturen mit Strukturtiefen von 1 Mikrometer bis 10000 Mikrometer, bevorzugt von 10 Mikrometer bis 1000 Mikrometer, besonders bevorzugt von 100 Mikrometer bis 800 Mikrometer, hergestellt werden.
5. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß
- 15 - Mikrostrukturen mit lateralen Abmessungen bis in den Bereich unter 10 Mikrometer hergestellt werden.
6. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß
- 20 - Mikrostrukturen mit einem Aspektverhältnis von 5 zu 1 bis 1000 zu 1, bevorzugt 10 zu 1 bis 100 zu 1, hergestellt werden.
7. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß
- 25 - als selektive Entwickler organische Lösemittel, glykolhaltige Alkalihydroxidlösungen oder alkoholische Alkali-hydroxidlösungen eingesetzt werden.
8. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß
- 30 - selektive Entwickler auf der Basis von Alkylglykolalkylether-alkylmonocarbonsäure-ester, bevorzugt Propylen-glykol-monomethylether-acetat, Ethylenglykol-butylether-acetat, Butylenglycol-isopropylether-propionat, eingesetzt werden.
9. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß
- 35 - Haftvermittler eingesetzt werden.

40

45

50

55



Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 98 11 5393

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrift Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.CI)
X	US 5 153 898 A (SUZUKI ET AL.) 6. Oktober 1992 * Spalte 19, Zeile 3-10 – Zeile 17-21 *	1-9	G03F7/039 G03F7/20
Y	US 4 756 989 A (AI ET AL.) 12. Juli 1988 * Anspruch 1 *	1-9	
Y	EP 0 375 929 A (IBM CORPORATION) 4. Juli 1990 * Seite 2, Zeile 20-22 * * Seite 5, Zeile 30-55 *	1-9	
A	US 5 415 977 A (WUENSCH ET AL.) 16. Mai 1995 * Ansprüche 1-5 *	1-9	
A	Y. ZHAANG ET AL.: "IGH aspect ratio micromachining Teflon by direct exposure to synchrotron radiation" APPL.PHYS. LETT., Bd. 67, Nr. 6, 7. August 1995, Seiten 872-874, XP000674181	1-9	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.CI)
A	EP 0 547 419 A (BASF AG) 23. Juni 1993 * Ansprüche 1,2,6,7 *	1-9	G03F
X,P	EP 0 851 295 A (ECOLE POLYTECHNIQUE DE LAUSANNE) 1. Juli 1998 * Spalte 1, Zeile 16-48 * * Spalte 3, Zeile 41-49 *	1-9	
X,P	H. LORENZ ET AL.: "Mechanical Characterization of a New High-Aspect-Ratio Near UV-Photorsist" MICROELECTRONIC ENGINEERING, Bd. 41/42, 1998, Seiten 371–374, XP004111658 Zusammenfassung	1-9 -/-	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Rechercheort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
MÜNCHEN	29. Oktober 1998	Thiele, N	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichttechnische Offenlegung P : Zwischenliteratur			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jülich erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			



Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 98 11 5393

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE												
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betritt Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)									
P, X	H.LORENZ ET AL.: "High-aspect-ratio, ultrathick, negative-tone photoresist and its application for MEMS" SENSORS AND ACTUATORS A, Bd. 64, Nr. 1, 1998, Seiten 33-39, XP004102135 Zusammenfassung -----	1-9										
RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)												
<p>Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Rechercherort: <b>MÜNCHEN</b></td> <td style="width: 33%;">Abschlußdatum der Recherche <b>29. Oktober 1998</b></td> <td style="width: 33%;">Prüfer <b>Thiele, N</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b>            X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet            Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie            A : technologischer Hintergrund            O : nichtschriftliche Offenkundigkeit            P : Zwischenliteratur         </td> </tr> <tr> <td colspan="3">           T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze            E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist            D : in der Anmeldung angeführtes Dokument            I : aus anderen Gründen angeführtes Dokument            S : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument         </td> </tr> </table>				Rechercherort: <b>MÜNCHEN</b>	Abschlußdatum der Recherche <b>29. Oktober 1998</b>	Prüfer <b>Thiele, N</b>	<b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b> X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenkundigkeit P : Zwischenliteratur			T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument I : aus anderen Gründen angeführtes Dokument S : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument		
Rechercherort: <b>MÜNCHEN</b>	Abschlußdatum der Recherche <b>29. Oktober 1998</b>	Prüfer <b>Thiele, N</b>										
<b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b> X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenkundigkeit P : Zwischenliteratur												
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument I : aus anderen Gründen angeführtes Dokument S : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument												

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 98 11 5393

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.  
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
Diese Angaben dienen nur zur Orientierung und erfolgen ohne Gewähr.

29-10-1998

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5153898 A	06-10-1992	JP 2556328 B JP 63312638 A JP 2628164 B JP 63312639 A JP 2673517 B JP 63312640 A JP 2628165 B JP 63312641 A JP 2711537 B JP 63311515 A JP 63311315 A JP 2603225 B JP 63018626 A EP 0252734 A	20-11-1996 21-12-1988 09-07-1997 21-12-1988 05-11-1997 21-12-1988 09-07-1997 21-12-1988 10-02-1998 20-12-1988 20-12-1988 23-04-1997 26-01-1988 13-01-1988
US 4756989 A	12-07-1988	JP 61255909 A JP 61022340 A JP 61032052 A JP 61143408 A JP 61143409 A JP 61143746 A DE 3524633 A FR 2567659 A GB 2163435 A, B	13-11-1986 30-01-1986 14-02-1986 01-07-1986 01-07-1986 01-07-1986 16-01-1986 17-01-1986 26-02-1986
EP 375929 A	04-07-1990	US 4940651 A DE 68927735 D JP 2259762 A US 5747223 A US 5300402 A US 5264325 A US 5439766 A	10-07-1990 13-03-1997 22-10-1990 05-05-1998 05-04-1994 23-11-1993 08-08-1995
US 5415977 A	16-05-1995	DE 4107851 A EP 0503377 A JP 5148369 A	17-09-1992 16-09-1992 15-06-1993
EP 547419 A	23-06-1993	DE 4141352 A AT 163096 T DE 59209181 D	17-06-1993 15-02-1998 12-03-1998

EPO FORM P0481

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 98 11 5393

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.  
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
 Diese Angaben dienen nur zur Orientierung und erfolgen ohne Gewähr

29-10-1998

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 547419 A		ES 2111601 T JP 5273758 A US 5518865 A	16-03-1998 22-10-1993 21-05-1996
EP 851295 A	01-07-1998	FR 2757961 A	03-07-1998